

Министерство образования и науки Украины
Национальная академия наук Украины
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова НАНУ
Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАНУ
Институт физики НАНУ
Институт сцинтилляционных материалов НАНУ
Национальный технический университет Украины «КПИ»
Национальный технический университет «Львовская политехника»
Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова

**VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"Функциональная база нанoeлектроники"**

14-18 сентября 2015г., г. Одесса, Украина

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе VIII Международной научной конференции "Функциональная база нанoeлектроники", которая состоится в г. Одесса 14-18 сентября 2015 года.

Для участия в конференции приглашаются: ученые, эксперты, специалисты, аспиранты, студенты, представители предприятий всех форм собственности, учебных заведений Украины и зарубежья.

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

-Физика и теория наноструктур для электроники
-Электродинамика и нанoeлектроника ТГц диапазона
-Метаматериалы и их применение в нанoeлектронике ТГц и ГГц диапазонов
-Методы формирования, диагностики и исследования наноструктур
-Математическое моделирование в нанoeлектронике
-Нанoeлектронные сенсоры и интеллектуальные системы на их основе. Нанoeлектронные сенсоры для биомедицины
-Магнитные наноструктуры для спиновой (и нано-) электроники ГГц и ТГц диапазонов
-МЭМС и НЭМС в электронике
-Нанofотоника. Процессы, структуры и устройства
-Элементы альтернативной энергетики, включая солнечные батареи, термо-преобразователи и накопители энергии
-Нелинейные процессы в искусственных средах/метаматериалах и приборы на их основе (Солитоны. Многочастотные процессы)

Организационный взнос для публикации материалов конференции:

для участников из Украины – **350 грн.**

для участников из стран СНГ - **30 Евро;**

для участников из дальнего зарубежья – **50 Евро.**

Минимальный оргвзнос включает в себя издание программы, сборника научных трудов конференции, а также затраты, связанные с покрытием расходов на организацию и проведение конференции, в том числе расходы на рекламу, связь, кофе-брейк и др.

О принятии Оргкомитетом докладов и о банковских реквизитах для перечисления денег Вы будете уведомлены до 25 августа 2015 г. во втором информационном письме.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:

Подача материалов для опубликования	05.08.2015
Уведомление о принятии материалов	25.08.2015
Начало регистрации, открытие конференции.	14.09.2015

ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ

необходимо предоставить:

- Заявку (Приложение 1).
- Электронную версию доклада (E-mail: innov@kture.kharkov.ua) на одном из рабочих языков (английский, русский, украинский), оформленного в соответствии с требованиями к оформлению доклада и прилагаемым образцом (Приложение 2).

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА:

- Объем – **2-4 полных** страницы формата **A4**, набранного в текстовом редакторе Microsoft Word.
- Поля – **30 мм**; абзацный отступ **1 см**.
- Гарнитура: Times New Roman, размер шрифта 11, интервал между строк – одинарный.
- Аннотация на английском языке (10-15 строк).
- Текст рукописи должен быть структурирован и содержать все *основные части, характерные для описания научного исследования*: **введение** (отражает *актуальность*, формулирование *цели и задач* исследования); **сущность** (изложение основного материала исследования с описанием идеи, метода и обоснованием полученных научных результатов); **выводы** (отражают результаты исследования, их *научную новизну* и *практическую значимость*, сравнение с мировыми

аналогами, перспективы); обязателен **список литературы** (до 5 источников).

- Формулы, символы, переменные, встречающиеся в тексте, должны быть набраны как объекты Microsoft Equation.
- Рисунки и таблицы должны быть четкими, компактными. Редакторы: CorelDraw, Table Editor, Microsoft Excel.
- Тексты докладов печатаются в авторском варианте без редактирования.

Порядок размещения материала:

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (большими буквами, жирно, по центру строки).

Следующей строкой – фамилии, инициалы авторов по центру строки.

Следующей строкой – полное название организации по центру строки.

Следующей строкой – почтовый адрес, телефон, E-mail организации или авторов.

Следующей строкой – аннотация на английском языке (10-15 строк).

Через строку – с абзаца печатать текст доклада.

Приложение 1

Форма заявки:

- Наименование научного направления.
- Фамилия, имя, отчество авторов (полностью), ученое звание, научная степень, должность.
- Полное название организации.
- Адрес для переписки с указанием индекса города, факс, контактный телефон (с указанием кода),
- E-mail.

Приложение 2

ОБРАЗЕЦ

СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ МАЛОЗАМЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ

Иванов И.И., Сергеев Н.А.

Харьковский национальный университет
радиоэлектроники

61166, Харьков, пр. Ленина, каф. системотехники,
тел. (057) 702-13-06, факс (057) 702-11-13

E-mail: ivanov@kture.kharkov.ua;

The given work is devoted to the modern developments in the field of microwave devices used measuring etc. ... (10-15 строк).

Текст доклада ...

Тезисы докладов (объемом 4 стр.) могут быть опубликованы в журнале «Радиотехника» (ISSN 0485-8972), с последующей возможной публикацией в журнале «Telecommunications and Radio Engineering» по рекомендации секции конференции.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:

61166, г. Харьков, просп. Ленина, 14, ХНУРЭ,
ИМО (комн. 437) К.т.:(057)702-13-97; Ф.: (057)
702-13-97; E-mail: innov@kture.kharkov.ua

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Сопредседатели: д.ф.-м.н., проф. Слипенченко Н.И.,
член-корр. НАНУ д.ф.-м.н., проф. Тарапов С.И.

Члены программного комитета:

- Беляев А.Е. – член-корр. НАНУ, проф., директор
Института физики
полупроводников им. В.Е.
Лашкарева НАНУ, г. Киев,
Украина
- Бондаренко И.Н. – проф., зав. каф. ХНУРЭ, г. Харьков,
Украина
- Вербицкий В.Г. – проф. НТУУ «КПИ», г. Киев,
Украина
- Гордиенко Ю.Е. – проф. ХНУРЭ, г. Харьков, Украина
- Готра З.Ю. – проф., зав. каф. НТУ «Львовская
политехника», г. Львов, Украина
- Гринев Б.В. – академик НАНУ, проф., зав. каф.
ХНУ им. В.Н. Каразина, г.
Харьков, Украина
- Зависляк И.В. – проф. Киевского национального
университета им. Т.Г.Шевченко, г.
Киев, Украина
- Костылев В.П. – нач. лаб. Института физики
полупроводников им. В.Е.
Лашкарева НАНУ, г. Киев,
Украина
- Кузнецов А.П. - проф., проректор по научной работе
Белорусского государственного
университета информатики и
радиоэлектроники, г.Минск,
Беларусь
- Мачехин Ю.П. – проф., зав. каф. ХНУРЭ, г. Харьков,
Украина
- Негрийко А.М. – член-корр. НАНУ, зам. директора
Института физики НАНУ, г. Киев,
Украина
- Павлюченко А. В. – директор Государственного НИЦ
сверхпроводниковой радиоэлек-
троники «Айсберг», г. Киев,
Украина
- Просвирнин С. Л. – проф. Радиоастрономического
института НАНУ, г. Харьков,
Украина
- Сизов Ф.Ф. – член-корр. НАНУ, проф. Института
физики полупроводников им. В.Е.
Лашкарева НАНУ, г. Киев,
Украина
- Скрышевский В.А. – проф., зав. каф. Института
высоких технологий Киевского
национального университета им.
Т.Г.Шевченко, г. Киев, Украина
- Chichkov B.N. - Prof., Dr., Head of the Nanotechnology
Departament Laser Zentrum,
Hannover, Germany
- Якименко Ю.И. – академик НАНУ, проф., первый
проректор НТУУ «КПИ», г. Киев,
Украина
- Ямпольский В.А. – член-корр. НАНУ, проф. ИРЭ им.
А.Я. Усикова НАНУ, г. Харьков,
Украина